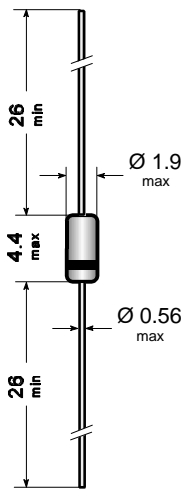


Small Signal Si-Diodes
Si-Allzweck-Dioden


Dimensions / Maße in mm

Nominal current Nennstrom	150 mA
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...100 V
Glass case Glasgehäuse	DO-35 SOD-27
Weight approx. Gewicht ca.	0.13 g
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	see page 17 siehe Seite 17

Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
1N 4148	75	100
1N 4150	50	50
1N 4151	50	75
1N 4448	75	100

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV}	150 mA ¹⁾
Max. power dissipation Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	500 mW ¹⁾
Peak forward surge current, single half sine-wave, superimposed on rated load Stoßstrom für eine 50Hz Sinus-Halbwellen, überlagert bei Nennlast	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	500 mA
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_J T_S	– 50...+200°C – 50...+200°C

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics, $T_i = 25^\circ\text{C}$ **Kennwerte, $T_i = 25^\circ\text{C}$**

Type	Forward voltage		Leakage current		Reverse recovery time *)
Typ	Durchlaßspannung		Sperrstrom		Sperrverzugszeit *)
	V_F [V]	at I_F [mA]	I_R [nA]	at V_R [V]	t_{rr} [ns]
1N 4148	< 1	10	< 25	20	< 4
1N 4150	< 1	200	<100	50	< 4
1N 4151	< 1	50	< 50	50	< 2
1N 4448	< 1	100	< 25	20	< 4

*) $I_F = 10$ mA through / über $I_R = 10$ mA to / bis $I_R = 1$ mA, $U_R = 6$ V, $R_L = 100\Omega$

Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft

$R_{thA} < 0.3$ K/mW¹⁾

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden